

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成20年3月6日(2008.3.6)

【公開番号】特開2005-191137(P2005-191137A)  
 【公開日】平成17年7月14日(2005.7.14)  
 【年通号数】公開・登録公報2005-027  
 【出願番号】特願2003-428245(P2003-428245)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 31/04 (2006.01)

H 0 1 M 14/00 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 31/04 W

H 0 1 M 14/00 P

H 0 1 L 31/04 Z

【手続補正書】

【提出日】平成20年1月21日(2008.1.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

導電性基板の一主面上に、色素を有し該色素の増感作用により光電変換を行なう色素増感型光電変換体と、光電変換を行なう非単結晶の半導体層を有し光を透過させる薄膜光電変換体とが、この順で積層されていることを特徴とする積層型光電変換装置。

【請求項2】

前記色素の分光感度のピーク波長が前記半導体層の分光感度のピーク波長より長波長側にあることを特徴とする請求項1に記載の積層型光電変換装置。

【請求項3】

前記半導体層はi型の非晶質シリコン層を備えたpin構造を有していることを特徴とする請求項1に記載の積層型光電変換装置。

【請求項4】

前記薄膜光電変換体は、前記導電性基板側から、触媒層と、第1の透明導電層と、非単結晶光電変換層と、第2の透明導電層とが順次積層されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の積層型光電変換装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

さらに、3)上記1)において、前記半導体層はi型の非晶質シリコン層を備えたpin構造を有していることを特徴とする。また、4)上記1)乃至3)のいずれかにおいて、前記薄膜光電変換体は、前記導電性基板側から、触媒層と、第1の透明導電層と、非単結晶光電変換層と、第2の透明導電層とが順次積層されていることを特徴とする。